

《GaN 研究コンソーシアム (SWG7) & 名古屋パワエレ塾共同開催研究会》
「パワーエレクトロニクス・モデリング技術最新動向」

平成 30 年 1 月

◆目的

パワーエレクトロニクス分野における次の技術として、設計開発におけるフロントローディングの考え方を導入したモデルベース開発が脚光を浴びています。その視点は、対象となる応用システム全体へと拡大し、巨視的な視点から部材、要素技術開発を再考することが急務とされています。これまでは我が国の“ものづくり”において各要素、材料について各領域の視点での「良いモノ」を作れば商機を勝ち得ていた時代は終わり、開発の川下の要求に効率良く応えるための特化した設計開発による、設計現場での低コスト化が求められています。本研究会は、こういった視点での新たな取り組みを紹介し、皆様の今後の技術開発の方向性の一助とさせて頂くものです。

◆今回の研究会のテーマ

パワーエレクトロニクス応用システムの開発におけるモデルベース開発の各事例を紹介します。まずはパワー半導体実装の最先端技術について基板技術、材料技術の視点から紹介していきます。さらにシステム開発の応用事例として、ハイブリッド車システムのモデリング技術について紹介します。さらにパワー半導体のモジュール実装技術におけるモデリング技術最前線について、2名のエンジニアの取り組みを紹介致します。

◇開催日時：

2018年 2月16日（金） 13:00～17:30

◇開催場所：

名古屋大学

ナショナルイノベーションコンプレックス(NIC) 3階 大会議室

(<http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/center/index.html>)

◇参加対象：パワーエレクトロニクス技術にご興味がある方

◇参加費：GaN 研究コンソーシアム会員： 無料

名古屋パワエレ塾会員 : 5,000 円

一般 : 10,000 円

◇プログラム：裏面

◆プログラム

13:00～13:05	座長挨拶	名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター教授 山本 真義 氏
13:05～13:50	《基調講演》 SiC パワーモジュールの解析モデルとこれを使った高速スイッチングの詳細解析	産業技術総合研究所 佐藤 伸二 氏
13:50～14:40	《招待講演》 車載パワエレ機器におけるノイズシミュレーションの事例紹介	株式会社デンソー 増澤 高志 氏
休 憩 (10分)		
14:50～15:35	《招待講演》 パワー半導体におけるモデル化と次世代半導体モジュールの実装技術	LG Japan Lab 株式会社 岩城 聡明 氏
15:35～16:20	《招待講演》 スイッチング特性を高精度に模擬できるパワーデバイスモデリング技術	ローム株式会社 黒田 尚孝 氏
16:30～17:30	交流会（カフェ形式）	

参加申し込み方法

下記の申込み窓口宛に、電子メールでお申し込みください。

申し込みの際は、

- ①参加者氏名 ② 所属機関 ③会員区分（GaN 研究コンソーシアム会員、パワエレ塾会員、一般）
- ④職業(役職) ⑤電話番号とメールアドレス

——の5点を明記してください。

場所・時間等の詳細は、参加登録後にメールでご連絡します。

個人情報を本研究会の参加登録以外の目的で使用する事、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】

G a N研究コンソーシアム／研究会事務局

E-MAIL: gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp (電話 052-747-6584)

【事 務 局】

名古屋大学

研究協力部 社会連携課：菱川 佳織、加藤 史征